

**ТЕХНОЛОГИЯ  
И  
КОНСТРУИРОВАНИЕ  
В  
ЭЛЕКТРОННОЙ  
АППАРАТУРЕ**

**НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ**

**2009 № 5 (83)**

**Год издания 33-й**

**ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР**

*К.т.н. В. М. Чмиль*

**РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ**

*К.т.н. Н. М. Вакив* (г. Львов)  
*Д.т.н. В. Н. Годованюк* (г. Черновцы)  
*К.т.н. А. А. Дацковский* (г. Киев)  
*Н. В. Кончиц* (г. Киев)  
*Д.т.н. В. П. Малахов* (г. Одесса)  
*Д.ф.-м.н. В. Ф. Мачулин* (г. Киев)  
*Д.т.н. М. К. Можсар* (г. Киев)  
*В. А. Проценко* (г. Киев)  
*Е. А. Тихонова* (г. Одесса)

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ**

*Д.т.н. С. Г. Антощук* (г. Одесса)  
*Д.т.н. А. А. Ащеулов* (г. Черновцы)  
*Д.т.н. В. В. Баранов* (г. Минск)  
*К.т.н. Э. Н. Глушченко*,  
зам. гл. редактора (г. Киев)  
*Д.т.н. В. В. Данилов* (г. Донецк)  
*Д.т.н. В. Т. Дейнега* (г. Одесса)  
*Д.ф.-м.н. В. А. Дроздов* (г. Одесса)  
*К.т.н. И. Н. Еримичай*,  
зам. гл. редактора (г. Одесса)  
*К.т.н. А. А. Ефименко*,  
ответственный секретарь (г. Одесса)  
*Д.ф.-м.н. Д. В. Корбутяк* (г. Киев)  
*Д.т.н. С. Ю. Лузин* (г. С.-Петербург)  
*К.т.н. И. Л. Михеева* (г. Киев)  
*Д.т.н. Ю. Е. Николаенко* (г. Киев)  
*Д.ф.-м.н. В. В. Новиков* (г. Одесса)  
*К.ф.-м.н. А. В. Рыбка* (г. Харьков)  
*К.т.н. В. В. Рохтин* (г. Черновцы)  
*Д. ф.-м. н. М. И. Самойлович* (г. Москва)  
*Д.т.н. В. С. Ситников* (г. Одесса)  
*Д.х.н. В. Н. Томашик* (г. Киев)  
*Д.ф.-м.н. О. И. Шпотюк* (г. Львов)

**УЧРЕДИТЕЛИ**

Министерство промышленной политики  
Украины  
Институт физики полупроводников  
им. В. Е. Лашкарёва  
Научно-производственное  
предприятие «Сатурн»  
Одесский национальный  
политехнический университет  
Издательство "Политехпериодика"

Одобрено к печати Ученым советом ОНПУ  
(Протокол № 2 от 27.10 2009 г.)

**СОДЕРЖАНИЕ**

**Новые компоненты для электронной аппаратуры**

Индуктивность, перестраиваемая электрическим полем. *Семёнов А. А., Усанов Д. А.* 3

**Электронные средства: исследования, разработки**

Гибридный автодинный сенсор магнитного резонанса. *Браиловский В. В., Верига А. Д., Политанский Л. Ф.* 7

Установка для измерения удельного коэффициента силы света материалов со световозвращающим эффектом. *[Бутенко В. К., Добровольский Ю. Г., Шабашкевич Б. Г., Юрьев В. Г.* 10

**Системы передачи и обработка сигналов**

Оптимизация процесса поиска неизвестного количества движущихся объектов. *Гришин И. Ю.* 13

**СенсоЭлектроника**

Оптимизация конструкции мембранных датчиков. *Рубцов И. И., Высоцкий В. Б., Ковалчук Н. С.* 16

**Функциональная микро- и наноэлектроника**

Разработка схемы и топологии элементов матрицы управляемых автоэмиссионных кремниевых микрокатодов. *Дружинин А. А., Голота В. И., Когут И. Т., Ховерко Ю. Н.* 20

Вольт-фарадные измерения в тонкопленочных эпитаксиальных структурах GaAs. *Горев Н. Б., Коджеспирова И. Ф., Привалов Е. Н.* 25

Фотоприемники ультрафиолетового излучения на основе тонких пленок ZnS. *Бобренко Ю. Н., Ярошенко Н. В., Шереметова Г. И., Семикина Т. В., Атдаев Б. С.* 29

Измерения ВАХ импульсных кремниевых ЛПД на участке лавинного пробоя. *Кудрик Я. Я.* 32

**Обеспечение тепловых режимов**

Прогнозирование показателей надежности двухкаскадного термоэлектрического охлаждающего устройства в режиме  $Q_{0\max}$ . *Зайков В. П., Киншова Л. А., Казанжи Л. Д., Храмова Л. Ф.* 34

**Технологические процессы и оборудование**

Корреляция параметров арсенид-галлиевых эпитаксиальных слоев и технологии их выращивания. *Каримов А. В., Ёдгорова Д. М., Якубов Э. Н.* 38

Исследование погрешности сопротивления тонкопленочного резистора. *Спирин В. Г.* 42

Формирование мезаструктур 4HSiC  $p-i-n$ -диодов методом ионно-плазменного травления. *Болтовец Н. С., Борисенко А. Г., Иванов В. Н., Федорович А. О., Кривуца В. А., Полозов Б. П.* 45

**Материалы электроники**

Наноструктурированная композитная пленка для сенсоров влажности. *Коваленко К. Л., Шаран Н. Н., Севастьянов В. В.* 49

Способ определения доли кристаллов в стеклокерамическом диэлектрике. *Дмитриев М. В., Еримичай И. Н., Панов Л. И.* 50

**Метрология. Стандартизация**

Малогабаритные цифровые частотомеры сверхвысокочастотного диапазона. *Криваль И. И., Скрипнюк А. И., Проценко В. А., Марьенко А. В.* 54

**Библиография**

Анотации к статьям номера 58

Новые книги 12, 15, 19, 28, 31, 48, 53, 57

В портфеле редакции 15

Выставки. Конференции 2-я, 4-я стр. обл.

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЖУРНАЛ

2009 № 5 (83)

Рік видання 33-й

ТЕХНОЛОГІЯ

ТА

КОНСТРУЮВАННЯ

В

ЕЛЕКТРОННІЙ

АПАРАТУРІ

(російською мовою)

### ЗМІСТ

#### Нові компоненти для електронної апаратури

Індуктивність, що перестроюється електричним полем. Семенов А. А., Усанов Д. А. (3)

#### Електронні засоби: дослідження, розробки

Гібридний автодинний сенсор магнітного резонансу. Брайловський В. В., Верига А. Д., Політанський Л. Ф. (7)

Установка для вимірювання питомого коефіцієнта сили світла матеріалів зі світлоповертаючим ефектом. Бутенко В. К., Добровольський Ю. Г., Шабашевич Б. Г., Юр'єв В. Г. (10)

#### Системи передавання та обробки сигналів

Оптимізація процесу пошуку невідомої кількості рухомих об'єктів. Гришин І. Ю. (13)

#### Сенсоелектроніка

Оптимізація конструкції мембраних датчиків. Рубцевич І. І., Висоцький В. Б., Ковалчук Н. С. (16)

#### Функціональна мікро- та наноелектроніка

Розробка схеми і топології елементів матриці керованих автогенсійних кремнієвих мікрокатодів. Дружинін А. О., Голота В. І., Когут І. Т., Ховерко Ю. М. (20)

Вольт-фарадні вимірювання в тонкоплівкових епітаксіальних структурах GaAs. Горев М. Б., Коджеспірова І. Ф., Привалов Є. М. (25)

Фотоприймачи ультрафіолетового випромінювання на основі тонких плівок ZnS. Бобренко Ю. М., Ярошенко М. В., Шереметова Р. І., Семікіна Т. В., Атдаєв Б. С. (29)

Вимірювання ВАХ імпульсних кремнієвих ЛПД на ділянці лавинного пробою. Кудрик Я. Я. (32)

#### Забезпечення теплових режимів

Прогнозування показників надійності двохкаскадного термоелектричного охолоджуючого пристроя в режимі  $Q_{0\max}$ . Зайков В. П., Кінішова Л. А., Казанжі Л. Д., Храмова Л. Ф. (34)

#### Технологічні процеси та обладнання

Кореляція параметрів арсенид-галієвих епітаксійних шарів і технології їх вирощування. Карімов А. В., Йодгорова Д. М., Якубов Е. Н. (38)

Дослідження похибки опору тонкоплівкового резистора. Спірин В. Г. (42)

Формування мезаструктур 4HSiC  $p-i-n$ -діодів методом іонно-плазмового травлення. Болтовець М. С., Борисенко А. Г., Іванов В. М., Федорович А. О., Кривуца В. А., Полозов Б. П. (45)

#### Матеріали електроніки

Наноструктурована композитна плівка для сенсорів вологості. Коваленко К. Л., Шаран М. М., Севаст'янів В. В. (49)

Спосіб визначення частки кристалів у склокерамічному діелектрику. Дмитрієв М. В., Єрімічой І. М., Панов Л. І. (50)

#### Метрологія. Стандартизація

Малогабаритні цифрові частотоміри надвисокочастотного діапазону. Криваль І. І., Скрипнюк О. І., Проценко В. О., Мар'єнко А. В. (54)

### CONTENT

#### New components for the electronic equipment

Electrical field controlled inductance. Semenov A. A., Usanov D. A. (3)

#### Electronic means: investigations, development

Hybrid autodyne sensor of a magnetic resonance. Brajilovskyj V. V., Veriga A. D., Politanskyj L. F. (7)

The installation for measuring of specific coefficient of force light materials with turn of light effect. Butenko V. K., Dobrovolsciy Yo. G., Shabashcevich B. G., Yuriev V. G. (10)

#### Systems of transfer and processing of signals

Search process optimization of unknown amount of train objects. Grishin I. Yu. (13)

#### Sensoelectronics

The optimization of design of the membrane sensor. Rubcevich I. I., Wysotsky V. B., Kovalchuk N. S. (16)

#### Functional micro- and nanoelectronics

Development of the circuit and layout of elements of an operated field emission silicon microcathodes matrix. Druzhinin A. A., Holota V. I., Kogut I. T., Khoverko Ju. M. (20)

Capacitance-voltage measurements in GaAs thin-film epitaxial structures. Gorev N. B., Kodzhespirova I. F., Privalov E. N. (25)

Ultraviolet photosensors based on ZnS thin films. Bobrenko Yu. N., Yaroshenko N. V., Sheremetova G. I., Semikina T. V., Atdaev B. S. (29)

The measurements of pulsed I-V-curves for silicon IMPATT diodes in the avalanche breakdown region. Kudryk Ya. Ya. (32)

#### Ensuring of thermal modes

Forecasting of parameters of reliability two-cascade thermo-electrical cooling device in a mode  $Q_{0\max}$ . Zaykov V. P., Kinshova L. A., Kazanji L. D., Khranova L. F. (34)

#### Technological processes and equipment

The correlation between parameters of gallium arsenic epitaxy layers and technology of growth's process. Karimov A. V., Yodgorova D. M., Yakubov E. N. (38)

Study of thin-film resistor resistance error. Spirin V. G. (42)

Forming of 4HSiC  $p-i-n$ -diodes mesastructures by the ion-plasma etching method. Boltovet M. S., Borisenko A. G., Ivanov V. N., Fedorovich A. O., Krivutsa V. A., Polozov B. P. (45)

#### Materials of electronics

Nanostructure composite film for sensor controls of humidity. Kovalenko K. L., Sharan N. N., Sevastyanov V. V. (49)

Method of determining of crystal part in glass-ceramic dielectric. Dmitriev M. V., Yerimichoy I. N., Panov L. I. (50)

#### Metrology. Standardization

Small size digital frequency counters of high-frequency range. Krival I. I., Skrypnyuk A. I., Protsenko V. A., Marjenko A. V. (54)